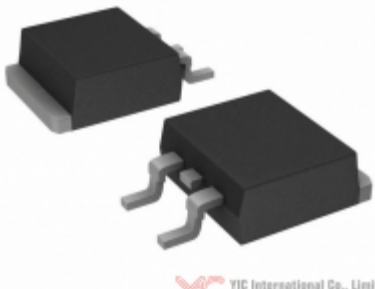









	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHB12N60E-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 12A TO263</p>
	<p>Datenblätter:  SIHB12N60E-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 42282 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHB12N60E-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 12A TO263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	42282 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 12A (Tc) 147W (Tc) Surface Mount
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	147W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	58nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	937pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Bulk
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIHB12N60EGE3

SIHB12N60E-GE3 ist neu im Original. Suche SIHB12N60E-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHB12N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHB12N60E-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIHB12N60ET1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 12A TO263</p>	 <p>SIHB12N60ET5-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 12A TO263</p>	 <p>SIHB12N50E-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 10.5A TO-263</p>	 <p>SIHB12N50E Vishay Precision Group SIHB12N50E VISHAY</p>
 <p>SIHB12N50E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 10.5A TO-263</p>	 <p>SIHB12N60E VISHAY SIHB12N60E VISHAY</p>	 <p>SIHB12N65E Vishay Precision Group SIHB12N65E Vishay</p>	 <p>SIHB12N65E-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 650V 12A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SIHA12N60E	↔ SIHA12N60E-E3	⇒ SIHA12N60E-E3	D SIHA22N60E-E3	↔ SIHA22N60E-E3
⊖ SIHA25N50E	⊕ SiHB12N50C	D SIHB12N50C-E3	⇒ SIHB12N50C-E3	↔ SIHB12N50E
⊕ SIHB12N60E	⊖ SIHB12N60E-GE3	⊕ SiHB12N65E	↔ SIHB15N50E	↔ SIHB15N60E-GE3
D SIHB15N60E-GE3	⊕ SiHB15N65E	⊖ SiHB16N50C	⊕ SIHB16N50CTR-E3	↔ SIHB18N60E
⇒ SIHB33N60E-GE3	↔ SIHB33N60E-GE3	⊕ SIHD3N50D-GE3	⊖ SIHD3N50D-GE3	↔ SIHD7N60E-GE3
↔ SIHD7N60E-GE3	⇒ SIHF10N40D	D SIHF10N40D-E3	⊕ SIHF10N40D-E3	⊖ SIHF12N50C
⊕ SIHF12N50C-E3	D SIHF12N50C-E3	⇒ SIHF12N60E	↔ SIHF12N60E-E3	↔ SIHF12N60E-E3
⊖ SIHF12N60E-GE3	⊕ SIHF12N60E-GE3	↔ SIHF12N60E-GE3	⇒ SIHF12N65E	↔ SIHF15N60E
⊕ SIHF15N60E-E3	⊖ SIHF15N60E-E3	⊕ SIHF15N60E-EG3	D SIHF15N60E-GE3	↔ SIHF15N60E-GE3
↔ SIHF16N50C	⊕ SIHF16N50C-E3	⊖ SIHF16N50C-E3	⊕ SIHF18N50C-E3	↔ SIHF18N50C-E3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited